72180 (\$256)

発送番号 378618 1/ 発送日 平成15年11月 4日

#### 拒絕理由通知書

特許出願の番号

平成11年 特許願 第505458号

平成15年10月24日

特許庁審査官 伊藤 昌哉

8808 2M00

特許出願人代理人

上柳 雅營(外 1名) 様

適用条文

起案日

第17条の2第3項、第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

FOO 4/1/ USO/ 斯酸 USO2 2飯 FOO 4036 USO) (公南

#### 理 由

1. 平成15年8月29日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。

記

本願の出願当初の明細書又は図面では、有機半導体膜による薄膜発光素子を備えたアクティブマトリクス型表示装置において、寄生容量を小さくするために、データ線と対向電極の間に厚い絶縁膜を設けるところ、無機材料あるいは有機材料のみで厚い絶縁膜を設ける構成には問題点があるので、半導体膜より厚く形成された無機材料からなる下層側絶縁膜と、下層側絶縁膜上に積層された有機材料あるいは無機材料からなる上層側絶縁膜とした、2層構造の絶縁膜により厚い絶縁膜を設けることを開示しており、この技術思想より広い概念の技術思想は、本願の出願当初の明細書又は図面からは読み取ることはできない。

すると、補正後の各請求項に記載された発明のうち、上記技術思想を記載していると認められるのは、補正後の請求項9、10、11に記載された内容をすべて含む構成である(なお、この補正後の請求項9、10、11に記載された内容をすべて含む構成にも、下記理由3に示すように不備が認められる)。

さらに、補正後の請求項6、12には、「前記第1の絶縁膜の幅は、前記第2の絶縁膜の幅より大であること」が記載されているが、本願の出願当初の明細書又は図面では、上層側絶縁膜は、下層側絶縁膜より狭い幅をもって<u>当該下層側絶縁膜の内側領域に積層する</u>構成とすることにより、有機材料から構成された上層側絶縁膜は、有機半導体膜により接しにくくなるという技術思想が開示されており、単に、上層側絶縁膜は、下層側絶縁膜より狭い幅である、つまり、第1の絶縁膜の幅は、第2の絶縁膜の幅より大であることが開示されているのではない。

以上のことから、補正後の各請求項に記載された発明のうち、本願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものと認められるのは、請求項11において、請求項9及び10を引用する発明、請求項13~19において、請求項9及び10を引用し、請求項12を引用しない発明である。

すなわち、補正後の各請求項に記載された発明のうち、これら、請求項11に おいて、請求項9及び10を引用する発明、請求項13~19において、請求項 9及び10を引用し、請求項12を引用しない発明以外の発明は、本願の出願当 初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものではない。

なお、補正後の各請求項に記載された発明のうち、これら、請求項11において、請求項9及び10を引用する発明、請求項13~19において、請求項9及び10を引用し、請求項12を引用しない発明以外の発明は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内にないことが明らかであるから、当該発明については新規性、進歩性等の特許要件についての審査を行っていない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

# 記(引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項11、15~19に対して 引用文献1

引用文献1に記載された「隔壁7」が、本願の「絶縁膜」に相当する。

「隔壁7」は、「Si3N4などの保護膜7a」の上に、「レジストまたは感光性ポリイミド等を選択的に形成」した、すなわち、無機材料を下層、有機材料を上層とした2層構造であることが記載されている。(段落【0017】)

「隔壁7」は、段落【0017】、図6に、走査線、データ線、導通制御回路 を覆っている構成であることが記載されている。

引用文献1には明記されていないが、「隔壁7」のような微細構造を形成する際には、角部が多少の丸みを帯びることは当然である。

## 引用文献等一覧

1. 特開平8-227276号公報 引例手配資

- 3. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第
- 1、2号に規定する要件を満たしていない。

記

### 請求項9について

· 「前記有機半導体膜は、絶縁膜により区画され」と記載されるのみで、どのような膜あるいは層の間に設けられたものであるのかが不明である。

発明の詳細な説明には、絶縁膜は、データ線と対向電極との間に設けられて、 これらの間の寄生容量を低減する作用を奏することが記載されている。

したがって、「前記有機半導体膜は、絶縁膜により区画され」という記載のみでは、発明の詳細な説明に記載された技術思想を、十分に記載しているとは認められない。

また、「前記有機半導体膜は、絶縁膜により区画され」という記載のみでは、 絶縁膜を設けたことの技術的意味が不明である。

・発明の詳細な説明には、画素電極、有機半導体膜、対向電極を具備する薄膜発 光素子が記載されるのみであるが、請求項9には、薄膜発光素子が記載されてい ない。

# 請求項11について

「前記絶縁膜」が、「第1の絶縁膜」、「第2の絶縁膜」、「第1の絶縁膜」と「第2の絶縁膜」とを合わせた「絶縁膜」の、どの絶縁膜であるのかが不明である。

なお、発明の詳細な説明では、下層側絶縁膜が有機半導体膜より厚く形成され た構成が記載されている。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

# 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版

G09F 9/00-9/46

H05B 33/00-33/28

· 先行技術文献

特開昭 6 0 - 1 7 4 7 9 号公報 引例手配资 特開平 8 - 2 0 2 2 8 7 号公報 引例手配资 特開平 1 1 - 2 4 6 0 4 号公報 引例手配済 特開平 1 1 - 6 5 4 8 7 号公報 引例手配済 国際公開第 9 8 / 1 2 6 8 9 号パンフレット 引例手配済

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

#### <補正等の示唆>

- (1) 明細書を補正した場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引くこと (特許法施行規則様式第13備考6)。
- (2)補正の際には、補正は、この出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項のほか、出願当初の明細書又は図面に記載した事項から自明な事項に限られる点に注意し、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書の記載箇所を明確に示したうえで主張されたい。意見書の記載形式は、特許異議申立における訂正請求書の記載形式を参考にされたい。
- (3) 出願当初の請求項1の記載において、絶縁膜がデータ線と対向電極との間に設けられた構成が明確になるような記載を追加するしたものが、本願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項からみて、本願の発明を規定するのに最低限必要なものであると判断される。

なお、上記の補正等の示唆は法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由 を解消するための一案である。明細書及び図面をどのように補正するかは出願人 が決定すべきものである。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第1部 ナノ物理

TEL. 03 (3581) 1101 内線3274

FAX. 03 (3592) 8858